带保护的 D 类音频驱动 IC----CSC3120

产品概述

CSC3120电路是一款高耐压、高速的MOSFET 栅极驱动器,专为超大输出功率的D类音频功率放大器应用而设计。采用灵活的开放式拓扑结构实现PWM调制。

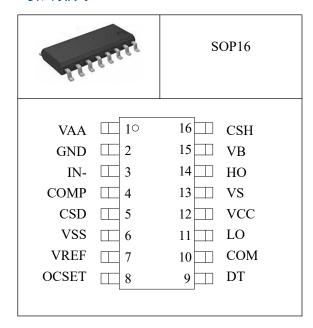
该产品具有双向过流检测与保护功能。该保护在没有任何外部采样电阻的情况下,感应负载正、负电流的过电流情况,并提供合适的过电流保护和可编程的复位定时。

该产品内置死区时间控制模块,精确设置 MOSFET栅极开关的死区时间,以获得极低的THD 和更小的音频输出背景噪声。

主要特点

- 集成模拟输入 D 类音频放大驱动器
- 可编程负载双向过流保护,具有自复位功能
- 可编程预设死区时间,提高 THD 性能
- 具有防开启期间和关闭期间的"咔哒"声
- 较好的背景噪声抑制
- 额定电压±100 V,输出功率超过 500 W
- 工作频率最高可达 800 kHz
- 驱动级输出电流能力Io+/-=1.0A/1.5A
- 双列 16 脚塑料封装(SOP16)
- 符合 RoHS

引脚排列



典型应用

- 家庭影院系统
- 迷你组件立体声系统
- 動力扬声器系统
- 通用音频功率放大器

版本:1.0

引出端功能

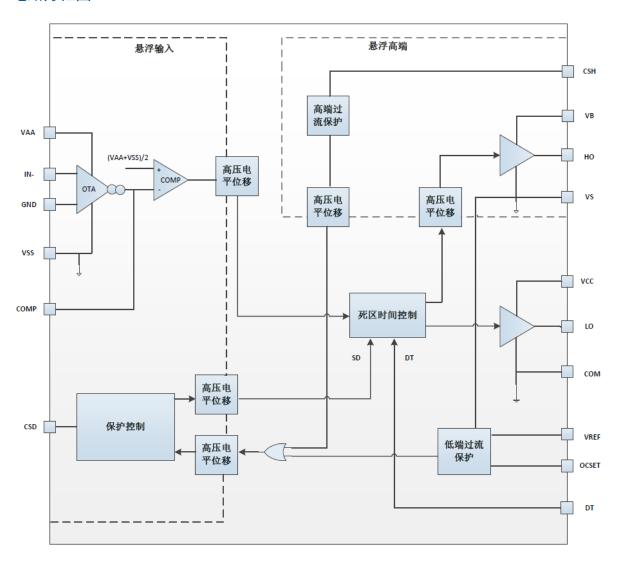
序号	符号	功能描述	序号	符号	功能描述
1	VAA	输入级正电源	9	CSH	上桥臂过流采样
2	GND	跨导放大器正输入	10	VB	上桥臂自举电源
3	IN-	跨导放大器负输入	11	НО	上桥臂驱动输出
4	COMP	相位补偿	12	VS	上桥臂悬浮端
5	CSD	保护延时设定	13	VCC	下桥臂电源
6	VSS	输入级负电源	14	LO	下桥臂驱动输出
7	VREF	基准电压源	15	COM	下桥臂公共端
8	OCSET	过流阈值设定	16	DT	死区调节

订货信息

产品名	封装形式	打印标记	装料形式	最小包装数
CSC3120	SOP16	CSC3120 XXXxX	编带	4k/卷

版本: 1.0 -2-

电路方框图



最大额定值 (无特别说明情况下, T_A=25℃)

符号	参数	最小值	最大值	单位
V_{B}	高端浮动电源电压	-0.3	220	
V_{S}	高端浮动电源电压(注 3)	V _B -20	$V_B+0.3$	
V_{HO}	高端浮动输出电压	V _S -0.3	$V_B+0.3$	
V_{CSH}	CSH 脚输入电压	V _S -0.3	$V_B+0.3$	
V_{CC}	低端固定电源电压(注 3)	-0.3	20	***
V_{LO}	低端输出电压	-0.3	V _{CC} +0.3	V
V_{AA}	浮动输入正电源电压(注 3)	(See I _{AAZ})	210	
$ m V_{SS}$	浮动输入负电源电压(注 3)	-1 (See I _{SSZ})	GND+0.3	
V_{GND}	浮动输入电源地电压	V _{SS} -0.3 (See I _{SSZ})	V _{AA} +0.3 (See I _{AAZ})	
I _{IN-}	反向输入电流(注 2)		±3	mA

版本: 1.0 - 3 -

V_{CSD}	CSD 脚输入电压	V _{SS} -0.3	V _{AA} +0.3	
V _{COMP}	COMP 脚输入电压	V _{SS} -0.3	V _{AA} +0.3	3 7
V_{DT}	DT 脚输入电压	-0.3	V _{CC} +0.3	V
Vocset	OCSET 脚输入电压	-0.3	V _{CC} +0.3	
I _{AAZ}	VAA 浮动输入正向钳位电流(注 3)	-	20	
I _{SSZ}	VAA 浮动输入负向钳位电流(注 3)	-	20	
I _{CCZ}	VCC 低端输入钳位电流(注 4)	-	10	mA
I _{BSZ}	VB 浮动输入钳位电流(注 4)	-	10	
I _{OREF}	VREF 参考端输出电流	-	5	
dV _S /dt	VS 允许的电压变化斜率	-	50	V/ns
dV _{SS} /dt	VSS 允许的电压变化率(注 4)	-	50	V/ms
P _D	最大功耗	-	1.0	W
R_{thJA}	热阻		115	°C/W
TJ	结温		150	
Ts	储存温度	-55	150	$^{\circ}$
$T_{\rm L}$	焊接温度(焊接,10秒)		300	

注意: (1) 如果器件运行条件超过上述各项最大额定值,可能对器件造成永久性损坏。上述参数仅是运行条件的极大值,我们不建议器件在该规范外运行。如果器件长时间工作在最大极限条件下,其稳定性可能会受到影响。

- (2) IN-到 GND 有双向箝位二极管。
- (3) V_{AA} -GND,GND- V_{SS} , V_{CC} -COM 和 V_{B} - V_{S} 包含内部的分流用齐纳二极管。请注意这些电压值会受到钳位电流的限制。
 - (4) 对于10V 阶跃信号的上升沿和下降沿, V_{ss} =15V \sim 200V。

推荐工作条件(无特别说明情况下,下表中 V_S 及 COM 偏置的额定值是在 $I_{AA}=5mA$, $V_{CC}=12V$, $V_{B}-V_{S}=12V$ 条件下测得, $T_{A}=25$ $^{\circ}$ $^{\circ}$

符号	参数	最小值	最大值	单位
V_{B}	高端浮动电源额定电压	V_S+10	V _S +18	V
V_{S}	高端浮动电源偏置电压	注1	200	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
I_{AAZ}	浮动输入电源正向箝位电流	1	11	A
I _{SSZ}	浮动输入电源负向箝位电流	1	11	mA
V_{SS}	浮动输入额定电压	0	200	
V_{HO}	高端浮动输出电压	Vs	V_{B}	
V_{CC}	低端额定电源电压	10	18	\mathbf{v}
V_{LO}	低端输出电压	0	V_{CC}	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
V_{GND}	GND 输入电压	Vss ^{注3}	$V_{AA}^{\stackrel{:}{lpha}3}$	
V _{IN-}	反向输入电压	V _{GND} -0.5	$V_{GND} + 0.5$	

版本: 1.0 -4-

V _{CSD}	CSD 脚输入电压	V_{SS}	V_{AA}	
V _{COMP}	COMP 脚输入电压	V_{SS}	V_{AA}	
C _{COMP}	COMP 脚对 GND 的相位补偿电容	1	-	nF
V_{DT}	DT 脚输入电压	0	V_{CC}	V
Ioref	VREF 参考输出电流-COM(注 2)	0.3	0.8	mA
Vocset	OCSET 脚输入电压	0.5	5	V
V_{CSH}	CSH 脚输入电压	Vs	V_{B}	V
dV _{SS} /dt	上电时 Vss 允许的电压变化率(注 4)	-	50	V/ms
I_{PW}	输入脉宽	10 ^{注5}	-	ns
f_{SW}	开关频率	-	800	kHz
T_A	环境温度	-40	125	$^{\circ}$ C

- 注 1: V_S 端逻辑电平可从-5~+200V 变化、实际逻辑状态从-5~- V_{BS} 间工作。
- 注 2: VREF 参考电压 5V, 当 VREF 外接 6.3k~16.7k Ω 时、I_{OREF} 从 0.3~0.8mA 变化。
- 注 3: GND 脚电压受限于 IAAZ 及 ISSZ。
- 注 4: 对于 10V 阶跃信号的上升沿和下降沿, $V_{SS}=0V\sim200V$ 。
- 注 5: 若输入脉宽小于最小脉宽设定、输出逻辑态可能出错。

电气参数 (无特别说明情况下, V_{CC}, V_{BS}=12V, V_{AA}=10V, V_{SS}=V_S=COM=0V, C_L=1nF 以及 T_A=25℃)

符号	参数	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件			
低端电源	低端电源								
UV _{CC+}	V _{CC} 输入 UVLO 正阈 值	8.4	8.9	9.4	V				
UV _{CC} -	V _{CC} 输入 UVLO 负阈 值	8.2	8.7	9.2	V				
I _{QCC}	低端静态电流	-	-	3	mA	$V_{DT} = V_{CC}$			
V _{CLAMPL}	低端钳位电压	19.6	20.4	21.6	V	I _{CC} =5mA			
高端浮动	电源								
UV _{BS+}	高端 UVLO 正阈值	8	8.5	9	3.7				
UV _{BS-}	高端 UVLO 负阈值	7.8	8.3	8.8	V				
I _{QBS}	高端静态电流	-	-	1	mA				
I_{LKH}	高端到低端漏电流	-	-	50	uA	$V_B = V_S = 200V$			
V _{CLAMPH}	高端钳位电压	19.6	20.4	21.6	V	I _{BS} =5 mA			
浮动输入时									
U_{VAA^+}	V _{AA} 输入 UVLO 正阈 值	8.2	8.7	9.2	V	V _{SS} =0V			
U _{VAA} -	V _{AA} 输入 UVLO 负阈 值	7.7	8.2	8.7	V	V _{SS} =0V			
I_{QAA0}	V _{AA} 输入静态电流	-	0.5	2	mA	$V_{AA}=9.5V, V_{CSD}=V_{SS}$			

- 5 -

版本: 1.0

CSC3120

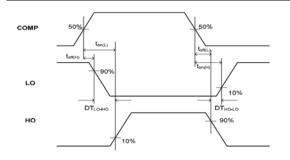
I_{QAA1}	V _{AA} 输入静态电流	-	3		10			$V_{AA}=9.5V$, $V_{CSD}=V_{AA}$
I_{QAA2}	V _{AA} 输入静态电流	-	3		10			V _{AA} =9.5V, V _{CSD} =GND
I_{LKM}	V _{AA} 浮动输入端到低端漏电流	-	-		50	u	A	$V_{AA}=V_{SS}=V_{GND}=100V$
V _{CLAMPM+}	V _{AA} 对 GND 正钳位电 压	6.0	7.0		8.0	,	V	$I_{AA}=I_{SS}=5 \text{ mA}$ $V_{GND}=0V$, $V_{CSD}=V_{SS}$
V _{CLAMPM} -	V _{ss} 对 GND 负钳位电 压	-8.0	-7.0		-6.0		v	$I_{AA}=I_{SS}=5 \text{ mA}$ $V_{GND}=0V, \ V_{CSD}=V_{SS}$
音频输入	$(V_{GND}=0V, V_{AA}=5V)$, V _{SS} =-5V))					
Vos	输入偏移电压	-15	0		15	m	ıV	
I_{BIN}	输入偏置电流	-	-		40	n	A	
BW	小信号带宽	-	9		-	М	Hz	$Rf=3.3k,C_{COMP}=2nF$
V_{COMP}	OTA 输出电压	V _{AA} -1	-	V	7 _{SS} +1	,	V	
gm	OTA 跨导	-	150		-	n	ns	V _{IN-} =10mV
Gv	OTA 增益	60	-		-	d	B	
$V_{ m Nrms}$	OTA 输入噪声电压	-	250		-	mVrms		
SR	斜率		±5			V	/us	C _{COMP} =1nF
CMRR	共模抑制比		60			15		
PSRR	电源抑制比		65			dl dl		
PWM 比较都	u P						•	
V_{thPWM}	COMP 门限电压	-	$\begin{pmatrix} V_{AA} \\ V_{SS} \end{pmatrix}$		-		V	
f_{OTA}	COMP 启动时本振频率	0.7	1.0		1.5		MHz	V _{CSD} =GND
保护		•	•					•
V_{REF}	基准输出电压	4.8	5.1		5.4			I _{OREF} =0.5mA
V_{thOCL}	低端 OC 阈值	1.1	1.2		1.3			O _{CSET} =1.2V,Fig.3
V_{thOCH}	VCSH 的高端 OC 阈 值	1.1+V _S	1.2+V	r _s	1.3+V _S		V	V _s =200V
V_{th1}	CSD 脚关闭阀值	0.62*V _{AA}	0.70*V	AA	0.78*V _{AA}			V _{SS} =0V
V_{th2}	CSD 脚自复位阈值	0.26*V _{AA}	0.30*V	AA	0.34*V	AA		V _{SS} =0V
I_{CSD^+}	CSD 脚放电电流	70	100		130			V _{CSD} =V _{SS} +5V
I _{CSD} -	CSD 脚充电电流	70	100		130		uA	V _{CSD} =V _{SS} +5V
t_{SD}	V _{CSD} > V _{SS} +V _{thOCH} 关 闭传播延迟时间	-	-		250		***	Fig.2
t _{OCL}	V _s > V _{thOCL} 关闭传播延迟时间	-	-		500) ns		Fig.3

版本: 1.0 -6-

CSC3120

$t_{\rm OCH}$	V _{CSH} > V _{thOCH} 关闭传播延迟时间	-	-	500		Fig.4
栅极驱动						
I_{o^+}	输出高短路电流	-	1.0	-		V _O =0V,PW<10μs
I _o -	输出低短路电流	-	1.5	-	A	V _O =12V,PW<10μs
V_{OL}	低电平输出电压 LO-COM,HO-VS	-	-	0.1	V	
V_{OH}	高电平输出电压 VCC-LO,VB-HO	-	-	1.0	V	I _O =0A
$t_{\rm r}$	开启上升时间	-	20	50		
t_{f}	关闭下降时间	-	15	35		
t_{on}	高端和低端开启传播 延迟,浮动输入	-	385	-		V -V
$t_{ m off}$	高端和低端关闭传播 延迟,浮动输入	-	360	-		V _{DT} =V _{CC}
DT1	死区时间: LO 关闭到 HO 打开以及 HO 关 闭到 LO 打开	15	25	35		V _{DT} >V _{DT1} ,
DT2	死区时间: LO 关闭到 HO 打开(DT _{LO-HO})以 及 HO 关闭到 LO 打 开(DT _{HO-LO})	25	40	55	nS	V _{DT1} >V _{DT} >V _{DT2} ,
DT3	死区时间: LO 关闭到 HO 打开(DT _{LO-HO})以 及 HO 关闭到 LO 打 开(DT _{HO-LO})	50	65	85		V _{DT2} >V _{DT} >V _{DT3} ,
DT4	死区时间: LO 关闭到 HO 打开(DT _{LO-HO})以 及 HO 关闭到 LO 打 开(DT _{HO-LO})	85	105	135		V _{DT3} >V _{DT} >V _{DT4} ,
V_{DT1}	DT 模式选择阈值 2	0.51*V _{cc}	0.57*V _{cc}	0.63*V _{cc}		
V_{DT2}	DT 模式选择阈值 3	0.32*V _{cc}	0.36xV _{cc}	0.40*V _{cc}	V	
V_{DT3}	DT 模式选择阈值 4	0.21*V _{cc}	0.23*V _{cc}	0.25*V _{cc}		

版本: 1.0 -7-



Vth1

CSD

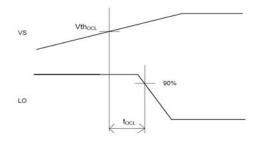
HO/LO

t_{SD}

90%

fig.1 COMP 到 LO 和 HO 延时

fig.2 CSD 保护延时



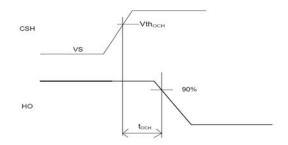
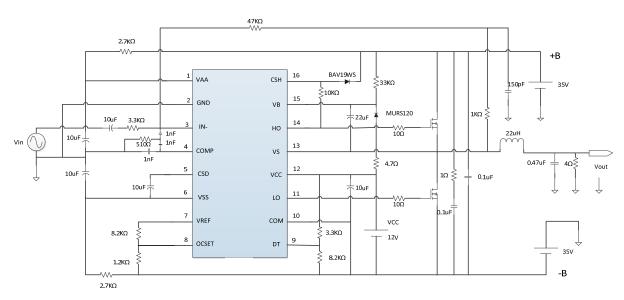


fig.3 Vs>VthOCL 保护延时

fig.4 V_{CSH}>V_{thOCH}保护延时

应用电路



封装外形图和尺寸

SOP16 D П п mm **SYMBOL** min max 1.75 Α 0.23 0.05 Α1 1.30 1.50 Α2 b 0.35 0.45 0.18 0.25 С 9.70 10.10 D 5.80 6.20 Ε 4.10 E1 3.70 e 1.27BSC 0.80 0.50 L 1.05BSC L1

注意事项

无锡市晶源微电子有限公司保留在任何时间做出更正、修改、增强、改进自己产品和服务的权利,并可在未经通知的情况下停止任何产品或服务。客户应该在下单前获取最新的相关信息,并确认这些信息是最新和完整的。

晶源微电子对客户使用本产品的设计方案不承担任何责任,客户需对他们的产品负责。为了将 客户产品相关风险降到最低,客户应该提供足够的安全工作区域。

在转售本公司产品和服务过程中,若有任何明示或暗示超出本公司承诺的陈述,本公司对此类陈述不承担任何责任。

版本: 1.0 - 10 -